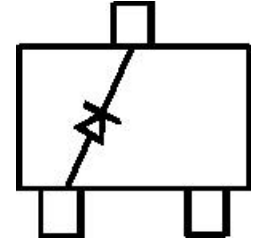


BAS21



SOT-23封装内部結構

■ FEATURES 特點

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Power dissipation 耗散功率	$P_D(T_a=25^\circ\text{C})$	225	mW
Forward Current 正向電流	I_F	200	mA
Reverse Voltage 反向電壓	V_R	250	V
Junction and Storage Temperature 結溫和儲蓄溫度	T_J, T_{stg}	150°C, -55to+150°C	

■ DEVICE MARKING 打標

BAS21=JS

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

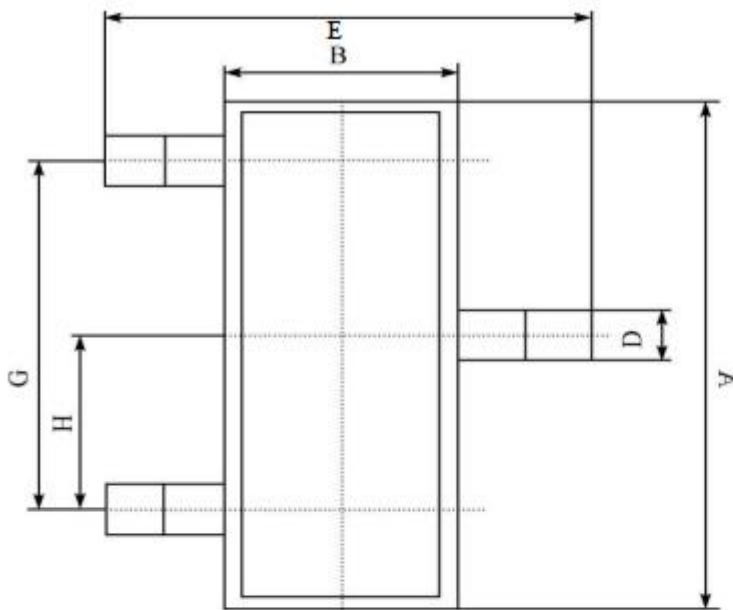
($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊说明, 溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 ($I_R=100\mu\text{A}$)	$V_{(BR)}$	250	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏電流 ($V_R=200\text{V}$)	I_R	—	1	μA
Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 $I_F=10\text{mA}$ $I_F=20\text{mA}$	V_F	—	1.0 1.25	V
Diode Capacitance 二極體電容 ($V_R=0\text{V}, f=1\text{MHz}$)	C_D	—	8	pF
Reverse Recovery Time 反向恢復時間	T_{rr}	—	50	nS

BAS21

■ **DIMENSION** 外形封裝尺寸

單位(UNIT): mm



代碼	範圍(單位:mm)
A	2.80~3.00
B	1.20~1.40
C	0.90~1.10
D	0.30~0.50
E	2.20~2.60
G	1.80~2.00
H	0.90~1.00
J	0.08~0.18
K	0.02~0.12
M	≥0.22
N	0.50~0.70
P	6°~10°

